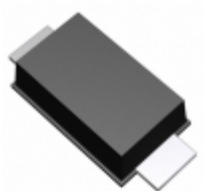


specificazioni	
Numero di parte	RF081M2STR
fabbricante	LAPIS Semiconductor
Descrizione	DIODE GEN PURP 200V 800MA PMDU
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Diodi-raddrizzatori-
Stato parte	309785 pcs Stock
Tensione - diretta (Vf) (max) a If	950mV @ 800mA
Tensione - inversa (Vr) (max)	200V
Contenitore dispositivo fornitore	PMDU
Velocità	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Tempo di ripristino inverso (trr)	25ns
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	SOD-123
Temperatura di funzionamento - Giunzione	150°C (Max)
Tipo montaggio	Surface Mount
Tipo diodo	Standard
Corrente - Dispersione inversa a Vr	10µA @ 200V
Corrente - raddrizzata media (Io)	800mA
Capacità a Vr, F	-

Potresti essere anche interessato:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RF081M2SGTR ROHM RF081M2SGTR ROHM	 RF081M2STF ROHM RF081M2STF ROHM	 RF081MM2STF ROHM RF081MM2STF ROHM	 RF081M2STFE ROHM ROHM 2016+RoHS
 RF081MM2STR Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 800MA PMDU	 RF081MM2S TR ROHM RF081MM2S TR ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RF081M2SG TR ROHM ROHM SOD123	 RF081M2STFTR ROHM ROHM SOD123

RF081M2STR Parola chiave correlata

Di Più

RF081M2STR LAPIS Semiconductor	Scheda tecnica RF081M2STR	Schede tecniche RF081M2STR	RF081M2STR PDF	LAPIS Semiconductor RF081M2STR
RF081M2STR elettronico	Componenti RF081M2STR	Distributore RF081M2STR	Immagine RF081M2STR	RF081M2STR Part
RF081M2STR Prezzo	RF081M2STR Produttore	Immagine RF081M2STR	Stock RF081M2STR	Inventario RF081M2STR
RF081M2STR Nuovo	RF081M2STR Originale	RF081M2STR garantito	RF081M2STR RFQ	RF081M2STR Ordina online